



SII NanoTechnology USA Inc.

Vortex[®] ME4

4 Element Silicon Drift X-Ray Detector

Total Active Area ~170mm²

4-channel digital pulse processor (xMAP from XIA):

FWHM (eV at 5.9keV)



ヒートシンクタイム	代表値	最大
12 μ s	<145	155
4 μ s	<150	160
1 μ s	<170	185
0.25 μ s	<250	275

ヒートシンクタイム	チャンネル毎出力計数率 (@50%デッドタイム)
12 μ s	>10,000 cps
4 μ s	>30,000 cps
1 μ s	>100,000 cps
0.25 μ s	>250,000 cps



Vortex

Vortex EX 60

Vortex EX 90

Vortex EM



●検出器

結晶材	4素子シリコン・ドリフト検出器(SDD)
有感面積	170mm ² (合計有感面積 ノミナル)
結晶厚	350 μm ±30 μm(ノミナル)
ウィンドウ材	ベリリウム
ウィンドウ厚	12.5 μm

●エネルギー分解能(FWHM) @ Fe-55 5.9keV

ピーキングタイム	典型値	最大値
@ 12 μs	<145eV	155eV
@ 4 μs	<150eV	160eV
@ 1 μs	<170eV	185eV
@ 0.25 μs	<250eV	275eV

●出力計数率(50%デッドタイム MnX線)

ピーキングタイム	典型値(cps)
@ 12 μs	>10,000
@ 4 μs	>30,000
@ 1 μs	>100,000
@ 0.25 μs	>250,000

●デジタルパルスプロセッサ(DPP)

ゲイン	16 bitDAC
ピーキングタイム	0.1 - 100 μs
スペクトルサイズ	1024, 2048, 4096, 8192 チャンネル
チャンネルサイズ	10eV
積分非直線性	フルスケール出力の0.1%以下

●プリアンプ

タイプ	チャージセンシティブ型、1.6 mV/keV ±10%、リセット<1 μs
信号の極性	ポジティブ

●消費電力

ノミナル電圧110/230V、最大40W(電源および検出器)、最大20W(xMAP unit)

●動作環境

温度:+5~+30℃、湿度:20~80%(結露の無いこと)

●寸法/重量

重量	4.3kg
長さ×高さ×幅	425×165×82mm
ケーブル長(標準)	3m

●ソフトウェア

xManager (from XIA) オプション

※製品の改良に伴い、予告無く記載内容を変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい。

【201008】



セイコー・イージーアンドジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 電話番号:03-5542-3101(代表) ファクシミリ:03-5542-3109
<http://www.sii.co.jp/segg/>

営業一課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 営業推進課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 システム営業課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 大阪営業所 豊中市新千里西町 1-1-4 千里中央ツインビル別館 1F 〒560-0083
 水戸営業所 水戸市大町 1-2-40 朝日生命ビル 5F 〒310-0062
 札幌営業所 札幌市中央区南十条西 6-6-18 札幌南十条ビル 2F 〒064-0810
 カスタマーサービス 千葉市美浜区中瀬 1-8 〒261-8507

電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109
 電話番号:03-5542-3105 ファクシミリ:03-5542-3109
 電話番号:03-5542-3107 ファクシミリ:03-5542-3109
 電話番号:06-6871-8494 ファクシミリ:06-6871-8495
 電話番号:029-227-4474 ファクシミリ:029-227-7734
 電話番号:011-552-2558 ファクシミリ:011-552-6685
 電話番号:043-211-1306 ファクシミリ:043-211-8204